

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-338794

(P2005-338794A)

(43) 公開日 平成17年12月8日(2005.12.8)

(51) Int.Cl.⁷

G09G 3/30

G09G 3/20

H05B 33/14

F I

G09G 3/30

J

G09G 3/30

K

G09G 3/20 612E

G09G 3/20 623F

G09G 3/20 623R

テーマコード(参考)

3K007

5C080

審査請求 未請求 請求項の数 23 O L (全 14 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2005-117708 (P2005-117708)

(22) 出願日 平成17年4月15日(2005.4.15)

(31) 優先権主張番号 特願2004-131013 (P2004-131013)

(32) 優先日 平成16年4月27日(2004.4.27)

(33) 優先権主張国 日本国(JP)

(71) 出願人 000116024

ローム株式会社

京都府京都市右京区西院溝崎町21番地

(74) 代理人 100079555

弁理士 梶山 信是

(74) 代理人 100079957

弁理士 山本 富士男

(72) 発明者 矢熊 宏司

京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株式会社内

(72) 発明者 藤沢 雅憲

京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機EL駆動回路の基準電流発生回路、有機EL駆動回路およびこれを用いる有機EL表示装置

(57) 【要約】

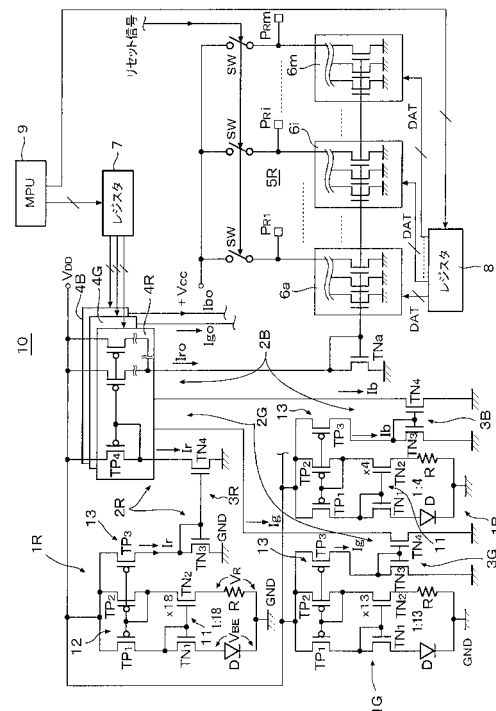
【課題】

広い範囲の表示装置使用温度環境において表示装置の発光輝度の変化を防止することができる有機EL駆動回路の基準電流発生回路を提供することにある。

【解決手段】

この発明は、入力側トランジスタと出力側トランジスタのそれぞれに直列に受動素子をそれぞれ有し前記それぞれの受光素子の温度係数が逆方向の特性になっている第1のカレントミラー回路と、出力側トランジスタの出力電流を入力側トランジスタの入力に帰還するために第1のカレントミラー回路の負荷回路として設けられた第2のカレントミラー回路とを備えていて、出力側トランジスタに発生する電流に応じた電流が基準電流として出力されて前記駆動電流が生成され、入力側トランジスタと出力側トランジスタとの動作電流の比が有機EL素子の温度変化に対する発光輝度の変化を抑える方向に補正する値に選択されているものである。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基準電流に基づいて有機 E L パネルの端子ピン対応に駆動電流を生成して前記有機 E L パネルを電流駆動する有機 E L 駆動回路の基準電流発生回路において、

入力側トランジスタと出力側トランジスタのそれぞれに直列に受動素子をそれぞれ有し前記それぞれの受光素子の温度係数が逆方向の特性になっている第 1 のカレントミラー回路と、

前記出力側トランジスタの出力電流を前記入力側トランジスタの入力に帰還するために前記第 1 のカレントミラー回路の負荷回路として設けられた第 2 のカレントミラー回路とを備え、

前記出力側トランジスタに発生する電流に応じた電流が前記基準電流として出力されて前記駆動電流が生成され、前記入力側トランジスタと前記出力側トランジスタとの動作電流の比が有機 E L 素子の温度変化に対する発光輝度の変化を抑える方向に補正する値に選択されている基準電流発生回路。

10

【請求項 2】

前記補正は、所定の温度範囲における温度変化に対して前記発光輝度が実質的に変化しないようにするものである請求項 1 記載の基準電流発生回路。

【請求項 3】

前記所定の温度範囲は、 -10° から $+70^{\circ}$ の範囲であり、前記温度に対する発光輝度の特性が実質的に平坦な特性となっている請求項 2 記載の基準電流発生回路。

20

【請求項 4】

前記第 2 のカレントミラー回路の出力側トランジスタとともにカレントミラー接続され前記基準電流を出力する他の出力側トランジスタを有する出力回路を備え、それぞれの前記受動素子は、ダイオードと抵抗である請求項 2 記載の基準電流発生回路。

【請求項 5】

前記入力側トランジスタと前記出力側トランジスタと前記第 2 のカレントミラー回路を構成する各トランジスタは MOS トランジスタで構成され、前記動作電流の比は、チャネル幅の比である請求項 2 記載の基準電流発生回路。

【請求項 6】

前記有機 E L 素子は、R、G、B の三原色の表示色に対応してそれぞれ設けられ、前記基準電流発生回路が R、G、B に対応してそれぞれ設けられている請求項 2 記載の基準電流発生回路。

30

【請求項 7】

R についての前記第 1 のカレントミラー回路の前記入力側トランジスタと前記出力側トランジスタとのチャネル幅の比は、 $1:16 \sim 1:20$ の範囲から選択され、G について前記第 1 のカレントミラー回路の前記入力側トランジスタと前記出力側トランジスタとのチャネル幅の比は、 $1:11 \sim 1:15$ の範囲から選択され、B について前記第 1 のカレントミラー回路の前記入力側トランジスタと前記出力側トランジスタとのチャネル幅の比は、 $1:2 \sim 1:6$ の範囲から選択されている請求項 6 記載の基準電流発生回路。

【請求項 8】

前記第 1 のカレントミラー回路を構成するトランジスタはペア特性のよいトランジスタとされる請求項 7 記載の基準電流発生回路。

40

【請求項 9】

基準電流発生回路からの基準電流に基づいて有機 E L パネルの端子ピン対応に駆動電流を生成して前記有機 E L パネルを電流駆動する有機 E L 駆動回路において、

前記基準電流発生回路からの前記基準電流を受けて調整した基準駆動電流を発生する基準電流調整回路を有し、前記駆動電流が前記基準駆動電流に基づいて生成され、

前記基準電流発生回路は、

入力側トランジスタと出力側トランジスタのそれぞれに直列に受動素子をそれぞれ有し前記それぞれの受光素子の温度係数が逆方向の特性になっている第 1 のカレントミラー

50

回路と、前記出力側トランジスタの出力電流を前記入力側トランジスタの入力に帰還するために前記第1のカレントミラー回路の負荷回路として設けられた第2のカレントミラー回路とを備え、

前記出力側トランジスタに発生する電流に応じた電流が前記基準電流として出力されて、前記入力側トランジスタと前記出力側トランジスタとの動作電流の比が有機EL素子の温度変化に対する発光輝度の変化を抑える方向に補正する値に選択され、
ている有機EL駆動回路。

【請求項10】

前記補正は、所定の温度範囲における温度変化に対して前記発光輝度が実質的に変化しないようにするものである請求項9記載の有機EL駆動回路。

10

【請求項11】

前記所定の温度範囲は、 -10° から $+70^{\circ}$ の範囲であり、前記温度に対する発光輝度の特性が実質的に平坦な特性となっている請求項10記載の有機EL駆動回路。

【請求項12】

前記基準電流発生回路は、前記第2のカレントミラー回路の出力側トランジスタとともにカレントミラー接続され前記基準電流を出力する他の出力側トランジスタを有する出力回路を備え、それぞれの前記受動素子は、ダイオードと抵抗である請求項10記載の有機EL駆動回路。

【請求項13】

前記入力側トランジスタと前記出力側トランジスタと前記第2のカレントミラー回路を構成する各トランジスタはMOSトランジスタで構成され、前記動作電流の比は、チャンネル幅の比である請求項10記載の有機EL駆動回路。

20

【請求項14】

前記有機EL素子は、R、G、Bの三原色の表示色に対応してそれぞれ設けられ、前記基準電流発生回路がR、G、Bに対応してそれぞれ設けられている請求項10記載の有機EL駆動回路。

【請求項15】

Rについての前記第1のカレントミラー回路の前記入力側トランジスタと前記出力側トランジスタとのチャンネル幅の比は、 $1:16 \sim 1:20$ の範囲から選択され、Gについて前記第1のカレントミラー回路の前記入力側トランジスタと前記出力側トランジスタとのチャンネル幅の比は、 $1:11 \sim 1:15$ の範囲から選択され、Bについて前記第1のカレントミラー回路の前記入力側トランジスタと前記出力側トランジスタとのチャンネル幅の比は、 $1:2 \sim 1:6$ の範囲から選択されている請求項14記載の有機EL駆動回路。

30

【請求項16】

さらに、第1および第2のD/A変換回路を有し、前記第1のD/A変換回路は、前記基準電流調整回路に設けられ、設定されたデータに応じて前記基準電流を調整して前記基準駆動電流を発生するものであり、前記第2のD/A変換回路は、前記基準駆動電流と表示データとを受けて前記有機ELパネルの端子ピン対応に前記駆動電流あるいはこの元となる電流を発生する請求項15記載の有機EL駆動回路。

【請求項17】

前記第2のD/A変換回路は、入力側トランジスタと多数の出力側トランジスタを有する第3のカレントミラー回路で構成され、前記基準駆動電流は、前記第3のカレントミラー回路の前記入力側トランジスタに入力され、前記第2のD/A変換回路は、前記第3のカレントミラー回路の前記多数の出力側トランジスタの電流が前記表示データのデジタル値に応じてスイッチングされることによって多数のアナログ変換電流を前記端子ピン対応にそれぞれ発生する請求項16記載の有機EL駆動回路。

40

【請求項18】

前記基準電流調整回路は、さらに電流反転回路を有し、前記第1のD/A変換回路は、第4のカレントミラー回路で構成され、この第4のカレントミラー回路の入力側トランジスタが前記電流反転回路を介して前記基準電流を受けて前記第4のカレントミラー回路の

50

多数の出力側トランジスタにアナログ変換電流を発生し、前記第3のカレントミラー回路の前記多数の出力側トランジスタは、変換対象となる前記表示データの重み桁に対応して設けられている請求項17記載の有機EL駆動回路。

【請求項19】

前記電流反転回路は、第5のカレントミラー回路で構成され、前記第1のカレントミラー回路と前記第3のカレントミラー回路と前記第5のカレントミラー回路とは、NチャネルMOSトランジスタで構成され、前記第2のカレントミラー回路と前記第4のカレントミラー回路とは、PチャネルMOSトランジスタで構成される請求項18記載の有機EL駆動回路。

【請求項20】

基準電流発生回路からの基準電流に基づいて有機ELパネルの端子ピン対応に駆動電流を生成して前記有機ELパネルを電流駆動する有機EL駆動回路を有する有機EL表示装置において、

前記基準電流発生回路からの前記基準電流を受けて調整した基準駆動電流を発生する基準電流調整回路を有し、前記駆動電流が前記基準駆動電流に基づいて生成され、

前記基準電流発生回路は、

入力側トランジスタと出力側トランジスタのそれぞれに直列に受動素子をそれぞれ有し前記それぞれの受光素子の温度係数が逆方向の特性になっている第1のカレントミラー回路と、前記出力側トランジスタの出力電流を前記入力側トランジスタの入力に帰還するために前記第1のカレントミラー回路の負荷回路として設けられた第2のカレントミラー回路とを備え、前記出力側トランジスタに発生する電流に応じた電流が前記基準電流として出力されて、前記入力側トランジスタと前記出力側トランジスタとの動作電流の比が有機EL素子の温度変化に対する発光輝度の変化を抑える方向に補正する値に選択されている有機EL表示装置。

【請求項21】

前記補正は、所定の温度範囲における温度変化に対して前記発光輝度が実質的に変化しないようにするものである請求項20記載の有機EL表示装置。

【請求項22】

前記所定の温度範囲は、 -10° から $+70^{\circ}$ の範囲であり、前記温度に対する発光輝度の特性が実質的に平坦な特性となっている請求項21記載の有機EL表示装置。

【請求項23】

前記有機ELパネルは、アクティブマトリックス型である請求項22記載の有機EL表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

この発明は、有機EL駆動回路の基準電流発生回路、有機EL駆動回路およびこれを用いる有機EL表示装置に関し、詳しくは、携帯電話機、PHS等の表示装置を有する電子機器において、表示装置のホワイトバランスを広い温度範囲で確保でき、表示装置使用の温度環境の変化によるホワイトバランスの崩れを防止することができるような高輝度カラー表示に適した基準電流発生回路に関する。

【背景技術】

【0002】

携帯電話機、PHS、DVDプレーヤ、PDA（携帯端末装置）等に搭載される有機EL表示装置の有機EL表示パネルでは、カラムラインの数が396個（ 132×3 ）の端子ピン、ローラインが162個の端子ピンを持つものが提案され、カラムライン、ローラインの端子ピンはこれ以上に増加する傾向にある。

このような有機EL表示パネルの電流駆動回路の出力段は、アクティブマトリックス型でもパッシブマトリックス型のものでも端子ピン対応に電流源の駆動回路、例えば、カレントミラー回路による出力回路が設けられている。

10

20

30

40

50

さらに、カラー表示の有機ELパネルの電流駆動回路は、R、G、Bの三原色対応の使用材料に応じて輝度調整をして表示画面上でホワイトバランスを採るために、R、G、B対応に表示画面上の輝度を調整する調整回路がそれぞれ設けられている。

マトリックス状に配置したR、G、Bの有機EL素子を電流駆動する電流駆動回路は、通常、R、G、B共通に基準電流発生回路が1つ設けられ、この基準電流発生回路の基準電流を受けて、R、G、Bに対応の基準電流設定回路が設けられ、これらが基準電流をそれぞれ調整してR、G、B対応の基準電流を発生する。そこで、基準電流設定回路により基準電流を調整することで表示画面上でホワイトバランスを採っている。調整されたR、G、Bの各基準電流は、R、G、Bに対応の各駆動回路に供給される。

ところで、定電流設定回路を設けて有機ELセグメント素子の駆動回路に定電流を供給してこの駆動回路をPWMパルスにより駆動して有機ELセグメント素子を発光させる技術が公知である（特許文献1）。これには、定電流設定回路の電流を調整することで経年変化による発光強度の低下を回復する技術が記載されている。

【特許文献1】特開2001-34221公報号

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

一般的に、有機EL表示装置を搭載した電子機器は、表示装置が使用可能な温度範囲（温度環境）が $-10^{\circ}\sim+70^{\circ}$ 程度と広い。そこで、高輝度カラー表示の有機EL表示装置で問題になるのが装置使用環境の温度変化による表示画面上でのホワイトバランスの崩れである。その原因は、R、G、Bの発光特性が温度に応じて変化することにある。しかも、その特性は、使用される有機EL素子の材料によって異なってくる。

図3（a）に実線で示すように、現在のところ、前記のような温度範囲では、Rの発光材料の温度特性は、右下がりの直線特性Rとなり、Gの発光材料の温度特性は、図3（b）に実線で示すように、 0° 付近の中央部で谷となった湾曲した特性Gとなり、Bの発光材料の温度特性は、図3（c）に実線で示すように、直線特性Rとは逆に左下がりの直線特性Bとなる。

なお、縦軸は、発光輝度 P_o と出力電流 I_o との比、すなわち、単位駆動電流当たりの輝度 P_o/I_o であり、横軸は温度 $[^{\circ}\text{C}]$ である。いずれの発光材料も発光輝度 P_o は、有機EL素子の使用温度範囲では、通常、出力電流 I_o に対して直線的な特性となり、かつ、それぞれに相違する温度特性になっている。

【0004】

その結果、ある温度環境（通常常温、例えば 25°C ）において設定された表示装置のホワイトバランスは、 $-10^{\circ}\sim+70^{\circ}$ 程度の範囲に互って表示装置使用の温度環境が変化すればホワイトバランスが崩れる問題がある。

この発明の目的は、このような従来技術の問題点を解決するものであって、広い範囲の表示装置使用温度環境において表示装置の発光輝度の変化を防止することができる有機EL駆動回路の基準電流発生回路を提供することにある。

この発明の他の目的は、表示装置のホワイトバランスを広い温度範囲で確保でき、表示装置使用の温度環境の変化によるホワイトバランスの崩れを防止することができる有機EL駆動回路あるいは有機EL表示装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0005】

このような目的を達成するためのこの発明の有機EL駆動回路の基準電流発生回路、有機EL駆動回路あるいはこれを用いる有機EL表示装置の構成は、基準電流に基づいて有機ELパネルの端子ピン対応に駆動電流を生成して有機ELパネルを電流駆動する有機EL駆動回路の基準電流発生回路において、

入力側トランジスタと出力側トランジスタのそれぞれに直列に受動素子をそれぞれ有し前記それぞれの受光素子の温度係数が逆方向の特性になっている第1のカレントミラー回路と、出力側トランジスタの出力電流を入力側トランジスタの入力に帰還するために第1

10

20

30

40

50

のカレントミラー回路の負荷回路として設けられた第2のカレントミラー回路とを備えていて、出力側トランジスタに発生する電流に応じた電流が基準電流として出力されて前記駆動電流が生成され、入力側トランジスタと出力側トランジスタとの動作電流の比が有機EL素子の温度変化に対する発光輝度の変化を抑える方向に補正する値に選択されているものである。

【発明の効果】

【0006】

このように、この発明にあっては、第1のカレントミラー回路の出力側トランジスタの電流を第1のカレントミラー回路のアクティブ負荷となる第2のカレントミラー回路を介して入力側トランジスタに帰還するように構成して、温度変化に応じて正、負逆特性の温度係数を持つ各受動素子に発生する電圧差に応じた電流が第1のカレントミラー回路の入力側トランジスタを介して出力側トランジスタに加えられるようにする。これにより第1のカレントミラー回路の出力側トランジスタに正、負の温度係数の特性が反映された所定の関数で決定される温度係数を持つ電流を安定的かつ大きな電流値として発生させることができる。そこで、この正、負の温度係数の特性が反映された大きな電流値の電流を第1のカレントミラー回路の出力側トランジスタから基準電流として取り出す。

さらに、有機EL素子の温度に対する発光輝度の変化特性を実質的に変化しない方向に補正するために第1のカレントミラー回路の入力側トランジスタと出力側トランジスタとの動作電流比を選択して前記の基準電流を生成する。

なお、この動作電流比の選択により正、負特性が反映された負の温度特性を持つ基準電流、正、負特性が反映された正の温度特性を持つ基準電流、そして正、負特性が反映された正と負の両者の温度特性を持つ基準電流をそれぞれに得ることができる。

【0007】

これにより、 $-10^{\circ}\sim+70^{\circ}$ 程度の範囲において表示装置の使用温度環境が変化しても輝度がほとんど変化しないような輝度に有機EL素子の発光輝度を補正する駆動電流を前記の各温度特性を持つ基準電流から得るものである。

特に、R、G、Bに対応のそれぞれの有機EL素子の温度に対する発光輝度の変化を実質的に変化しない方向に補正するそれぞれの温度特性を持つ基準電流を前記の動作電流の比をそれぞれに選択してそれぞれに得るようにすれば、この発明は、 $-10^{\circ}\sim+70^{\circ}$ 程度の表示装置使用範囲においてカラー表示装置におけるホワイトバランスの崩れを防止することができる。

その結果、広い範囲の温度環境において表示装置の発光輝度の変化が防止され、カラー表示をする表示装置にあっては、表示装置を使用する広い温度範囲でホワイトバランスを確保することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0008】

図1は、この発明の有機EL駆動回路を適用した一実施例の有機ELパネルのカラムドライバを中心とするブロック図、図2は、基準電流発生回路を構成するカレントミラー回路の入力側トランジスタ対出力側トランジスタのチャネル幅（ゲート幅）比をパラメータとした場合の駆動電流の温度特性の説明図、そして、図3は、R、G、Bの発光材料の出力電流に対する一般的な温度特性の説明図である。

図1において、10は、有機ELパネルを駆動する有機EL駆動回路としてのカラムICドライバ（以下カラムドライバ）である。このカラムドライバ10は、R（赤）に対応して設けられた基準電流発生回路1Rと、G（緑）に対応して設けられた基準電流発生回路1G、そして、B（青）に対応して設けられた基準電流発生回路1Bとをそれぞれ有している。さらに、各基準電流発生回路に対応してそれぞれの基準電流を調整するRのホワイトバランス調整回路2Rと、Gのホワイトバランス調整回路2G、そして、Bのホワイトバランス調整回路2Bとが設けられている。

【0009】

各ホワイトバランス調整回路2R、2G、2Bは、それぞれ電流反転回路3RとD/A

10

20

30

40

50

変換回路 (D/A) 4 R、電流反転回路 3 G と D/A 変換回路 (D/A) 4 G、そして電流反転回路 3 B と D/A 変換回路 (D/A) 4 B とからなる。各ホワイトバランス調整回路 2 R、2 G、2 B は、それぞれの基準電流発生回路 1 R、1 G、1 B から出力される基準電流 I_r 、 I_g 、 I_b をそれぞれ入力段の電流反転回路 3 R、3 G、3 B でそれぞれ受けてカレントミラー回路の 8 ビットの D/A 変換回路 (D/A) 4 R、4 G、4 B でそれぞれの基準電流の電流値を調整する。これにより D/A 4 R、4 G、4 B (以下これらを区別せずに D/A 4 として説明する。) は、それぞれの R、G、B に対応して調整された基準電流 I_{ro} 、 I_{go} 、 I_{bo} (以下基準駆動電流 I_{ro} 、 I_{go} 、 I_{bo} という) をそれぞれに発生する。

ここで、基準電流 I_{ro} 、 I_{go} 、 I_{bo} は、レジスタ 7 の R、G、B 対応のデータがそれぞれに R、G、B 対応の各 D/A 4 に設定されて R、G、B 対応の各 D/A 4 がこのレジスタ 7 に記憶されたデータをそれぞれに D/A 変換することでそれぞれに生成される。レジスタ 7 に記憶されるデータは、装置外部から入力データとして MPU 9 に供給された、R、G、B 対応のデータを MPU 9 が受けて一旦内部にそれらを不揮発性メモリ等に記憶し、このデータを MPU 9 がレジスタ 7 に転送することでレジスタ 7 に設定されることによる。

【0010】

各ホワイトバランス調整回路 2 R、2 G、2 B で生成された基準駆動電流 I_{ro} 、 I_{go} 、 I_{bo} は、それぞれ R、G、B に対応のカレントミラー回路 5 R、5 G、5 B (5 G、5 B は図示せず) の入力側トランジスタをそれぞれに駆動する。これによりそれぞれのカレントミラー回路 5 R、5 G、5 B は、各出力端子対応に設けられた多数の出力側トランジスタに基準駆動電流 I_{ro} 、 I_{go} 、 I_{bo} を分配する。

なお、各ホワイトバランス調整回路 2 R、2 G、2 B は、同一構成の回路であり、ホワイトバランス調整回路 2 G、ホワイトバランス調整回路 2 B にそれぞれ接続されるカレントミラー回路 5 G、5 B は、ホワイトバランス調整回路 2 R が接続されているカレントミラー回路 5 R と同様な構成であるので、G、B に対応するカレントミラー回路 5 G、5 B は図 1 に図示してはいない。基準電流発生回路 1 R、1 G、1 B については、図 1 に示すように、基本回路構成は同じであるが、カレントミラー回路を構成するトランジスタのチャネル幅比がそれぞれに相違するので図示してある。

以下では、基準電流発生回路 1 R とホワイトバランス調整回路 2 R とカレントミラー回路 5 R との関係を中心に説明する。基準電流発生回路 1 G、1 B とホワイトバランス調整回路 2 G、2 B とそれぞれのカレントミラー回路 5 G、5 B との関係については基本的な動作は変わらないので割愛する。

【0011】

基準電流発生回路 1 R、1 G、1 B は、周囲の温度変化に応じて出力電流 (基準電流) が変化する、温度に応じて出力電流値が可変の定電流回路である。これらは、カレントミラー回路 1 1 とこのカレントミラー回路 1 1 のアクティブ負荷となる負荷回路 (カレントミラー回路) 1 2 と、この負荷回路 1 2 + にカレントミラー接続された基準電流出力回路 1 3 とからなる。

ダイオード D は、例えば、ダイオード接続トランジスタで構成され、トランジスタのベース-エミッタ間電圧であるバンドギャップ電圧に相当する負の温度特性を有する電圧 V_{BE} を発生する。このダイオード D がカレントミラー回路 1 1 の入力側の N チャネル MOS トランジスタ T_{N1} のソースとグラウンド GND との間に挿入されている。また、抵抗値が正の温度特性を有する抵抗 R がカレントミラー回路 1 1 の出力側の N チャネル MOS トランジスタ T_{N2} のソースとグラウンド GND との間に挿入されている。

トランジスタ T_{N1} 、 T_{N2} の共通に接続されたゲートは、トランジスタ T_{N1} のドレインに接続され、トランジスタ T_{N1} 、 T_{N2} のドレインは、それぞれ負荷回路 1 2 のカレントミラー回路の P チャネル MOS トランジスタ T_{P1} 、 T_{P2} のドレインにそれぞれ接続され、これらトランジスタを介して電源ライン +VDD に接続されている。負荷回路 1 2 は、トランジスタ T_{P2} がダイオード接続された入力側トランジスタであり、トランジスタ T_{P1} が出力側

トランジスタとなっている。

【0012】

基準電流出力回路13は、負荷回路12のトランジスタTP2にカレントミラー接続された出力側のPチャネルのMOSトランジスタTP3からなる。

以上のような回路では、カレントミラー回路11の出力側トランジスタTN2の電流がカレントミラー回路11のアクティブ負荷となるカレントミラー回路12の入力側トランジスタTP2、出力側トランジスタTP1を介してカレントミラー回路11の入力側トランジスタTN1に帰還される。そこで、温度変化に応じて負特性の温度係数を持つダイオードDと温度変化に応じて正特性の温度係数を持つ抵抗Rに発生する電圧差に応じた電流がカレントミラー回路の入力側トランジスタTN1を介して出力側トランジスタTN2に加えられる。これによりカレントミラー回路11の出力側トランジスタTN2に正、負特性が反映された関数で決定される所定の温度係数を持つ電流を安定的かつ大きな電流値として発生させることができる。

ここで、基準電流発生回路1R、1G、1Bの相違は、カレントミラー回路11のトランジスタTN1、TN2のチャネル幅比にある。すなわち、Rの基準電流発生回路1RではトランジスタTN1、TN2のチャネル幅比が1:18であり、Gの基準電流発生回路1GではトランジスタTN1、TN2のチャネル幅比が1:13であり、Bの基準電流発生回路1GではトランジスタTN1、TN2のチャネル幅比が1:4である。

なお、この実施例における基準電流発生回路1（基準電流発生回路1R、1G、1Bの代表として）のカレントミラー回路11のチャネル幅（ゲート幅）比の1:n（nは2以上の整数）におけるnは、複数のトランジスタセルを並列に複数個接続して構成してもよいことはもちろんである。

【0013】

電流反転回路3Rは、ホワイトバランス調整回路2Rにおいて示すように、Nチャネルの入力側MOSトランジスタTN3と出力側MOSトランジスタTN4からなるカレントミラー回路で構成されている。ダイオード接続のトランジスタTN3は、そのドレインが基準電流出力回路13のPチャネルのMOSトランジスタTP3のドレインに接続され、基準電流Irを受ける。

トランジスタTN4は、そのドレインがD/A4Rのカレントミラー回路の入力側トランジスタTP4のドレインに接続され、そのソースが接地されている。

これにより、基準電流出力回路13から吐き出される基準電流Irが電流反転回路3Rに入力されて電流方向が吐き出しからシンク電流に反転されて、ミラー電流として出力される。このシンク電流が入力側トランジスタTP4のドレインに供給されて、D/A4Rの入力側トランジスタTP4が電流Irにより駆動される。

D/A4Rは、レジスタ7に記憶されたデータに従って基準電流Irを調整して、調整された基準駆動電流Iroを出力する。なお、D/A4Rは、カレントミラー回路構成の電流スイッチングD/Aであるので、多数の出力側トランジスタの電流がレジスタ7に設定されたデジタル値に応じてON/OFFするスイッチ回路により選択されることで基準電流Irを電流増幅しかつ調整したアナログ変換電流を基準駆動電流Iroとして発生する。

【0014】

ここでのカレントミラー回路5Rは、基準電流分配型D/A変換回路を構成している。

すなわち、基準電流分配回路を構成するカレントミラー回路において、入力側トランジスタ：出力側トランジスタの比1:n（ただし、nは出力端子数に対応）で構成されるカレントミラー回路のn個の出力側トランジスタ部分をそれぞれにn個の電流スイッチングのD/A変換部に置き換えたものである。各D/A変換部の多数の出力側トランジスタの電流は、デジタル値に応じてスイッチングされてアナログ変換電流として出力端子ピン対応に分配されたものになる。

図示するように、アナログ変換電流を発生する部分は、少なくとも1個の入力側トランジスタTNaに対して、出力端子ピン対応に設けられた多数の出力側トランジスタを有するD/A変換ブロック6a~6mとして提供される。

10

20

30

40

50

各D/A変換ブロック6a～6mは、それぞれダイオード接続のNチャネルの入力側MOSトランジスタTNaに対してカレントミラー接続された、変換対象となる8ビットの表示データの重み桁に対応する重み桁を持つ多数の出力側トランジスタとこれらに接続された多数のスイッチ回路（図示せず）とからなる。

トランジスタTNaのドレインは、D/A4Rの出力に接続され、調整された基準駆動電流Iroを受けて駆動される。トランジスタTNaのソースは接地されている。

カレントミラー回路5Rをこのような基準電流分配型のD/A変換回路とすることで、カラムドライバ10のICにおいては基準電流分配からD/A変換回路までの回路規模を低減することができる。

【0015】

各D/A変換ブロック6a～6mは、各出力側トランジスタの電流出力がレジスタ8の8ビットの表示データに応じてON/OFFするスイッチ回路により選択されて選択された電流を合計した出力をアナログ変換値として発生する。各D/A変換ブロック6a～6mの出力端子が出力端子PR1, … PRi, …… PRmの1つにそれぞれ接続され、合成された電流出力（アナログ変換電流）が出力端子PR1, … PRi, …… PRmにそれぞれ送出される。

なお、D/A変換ブロック6（D/A変換ブロック6a～6mを代表して）の出力側トランジスタのソース側は接地されている。

その結果、D/A変換ブロック6は、MPU9からレジスタ8を介して表示データDATを受けて基準駆動電流Iroを表示データ値分増幅してそのときどきの表示輝度に応じた駆動電流（通常はシンク電流）を出力端子PR1, … PRi, …… PRm対応にそれぞれ発生する。そして、これら駆動電流は、出力端子PR1, … PRi, …… PRmを介してそれぞれにアクティブマトリックス型の有機ELパネル（図示せず）のm個のRに対応するデータ線（カラム線）に出力される。これにより、各駆動電流は、データ線（カラム線）を介してそれぞれに接続されたピクセル回路に送出されてRに対応するピクセル回路に内蔵されたコンデンサCを充電して各ピクセル回路の有機EL素子を駆動する。

このようなD/A変換ブロック6による駆動は、ホワイトバランス調整回路2G, 2Bでそれぞれ生成された基準駆動電流Igo, Iboを受けるG, BについてのD/A変換ブロックについても同様である。

なお、各出力端子PR1, … PRi, …… PRmには、電源ライン+Vccとの間に定電圧リセットを行うアナログスイッチSWがそれぞれに設けられている。

【0016】

ここで、基準電流発生回路1R, 1G, 1Bに戻り、その動作について説明する。

基準電流発生回路1（各基準電流発生回路1R, 1G, 1Bとして）のカレントミラー回路11のトランジスタTN2に注目する。トランジスタTN2のゲートを入力としてトランジスタTN2のドレインを出力とした回路を考えると、トランジスタTN2のゲートの電圧は、抵抗Rの抵抗値の温度特性に従って周囲の温度に応じてこのソース電圧が変化するので、これに対応して変化する。これによるトランジスタTN2のドレインの出力電流は、トランジスタTP2を駆動して、これにカレントミラー接続されたトランジスタTP1を駆動する。トランジスタTP1のドレインは、入力側トランジスタTN1のダイオード接続を介してトランジスタTN2のゲートに接続されている。したがって、トランジスタTP1のドレインを介してトランジスタTN2に戻る帰還ループがここに形成されている。

一方、入力側トランジスタTN1のゲート電圧は、ダイオードDの温度特性に従って周囲の温度に応じてこのソース電圧が変化するので、これに対応して変化する。

その結果、トランジスタTN2のゲートの入力電圧は、温度変化に応じて発生するダイオードDの電圧VBEと抵抗Rの電圧VRの差に応じて発生したトランジスタTN2のドレインの電流に応じて決定されるドレインの電圧に一致するようにフィードバック制御される。

そこで、この基準電流発生回路1は、温度変化に応じて発生するトランジスタTN2のゲート電圧に応じてトランジスタTN2のゲートとトランジスタTP1のドレインの電圧が等しくなるところで安定する。

10

20

30

40

50

【0017】

具体的には、ある温度でダイオードDの電圧VD（VDはダイオードDの端子電圧VBEとする。）が基準値よりも大きくなり、抵抗Rの電圧が基準値よりも小さくなったとする。これに応じて電流がトランジスタTN2のドレインの電流が増加して、この負荷となるトランジスタTP2のドレインの電圧を下げる。これによりトランジスタTP2のソースーゲート電圧差が大きくなってソースードレイン間の電流が増加する。その結果、トランジスタTP1のソースードレイン間の電流も増加してトランジスタTN2の低下したドレインの電圧に対応してトランジスタTN1のドレインの電圧が低下する。これにより、そのときどきの温度に応じてトランジスタTN1とトランジスタTN2のドレイン電圧が等しくなって、バランスしてその状態が維持される。

10

ダイオードDの電圧VDと抵抗Rの電圧VRによる差がトランジスタTN2のゲートーソース間を下げる方向（ゲートーソース間の電圧の差が小さくなる方向）であるときには前記とは逆の動作になる。

このときのトランジスタTN2のゲートーソース間の電圧は、負の温度係数を持つダイオードDの電圧VDと正の温度係数を持つ抵抗Rの電圧VRとが逆の温度特性となっているので、これら温度特性が総合された結果になる。その総合特性は、カレントミラー回路11の動作電流比で異なってくる。

【0018】

ここで、この基準電流発生回路1のカレントミラー回路11のチャンネル幅（ゲート幅）比を1:nとしてnの数値をパラメータとした場合の動作について考えてみる。

20

前記したように、基準電流発生回路1は、帰還ループが形成されて動作するので、次の(1)式が成立する。

$$V_{GS1} + V_D = V_{GS2} + I_{D2} \cdot R \cdots (1)$$

ただし、 V_{GS1} 、 V_{GS2} は、それぞれトランジスタTN1、TN2のゲートーソース間電圧、VDはダイオードDの端子電圧VBE、Rは抵抗Rの抵抗値である。 I_{D1} 、 I_{D2} は、それぞれトランジスタTN1、TN2のドレイン電流である。

ゲートーソース電圧VGSは、

$$V_{GS} = V_{th} + \sqrt{(2 I_D / \beta N)} \cdots (2)$$

ただし、 V_{th} は、MOSトランジスタの閾値電圧、 I_D は、ドレイン電流、Nは反転層内の単位面積当たりの電子数、 β は定数であって、 $\beta = W/L \cdot \mu_n C_{ox}$ である。 W/L は、チャンネル幅／チャンネル長、 μ_n は電子移動度、 C_{ox} は、ゲート酸化膜の単位面積当たりの容量である。

30

ここで、トランジスタTN1、TN2はペアトランジスタであるとする、トランジスタTN1、TN2の閾値電圧 V_{th} と β は等しく、 $I_{D1} = I_{D2} = I_D$ となる。

その結果、前記の(1)式に(2)式を代入すると、

$$(V_{th} + \sqrt{(2 I_D / \beta N_1)}) + V_D = (V_{th} + \sqrt{(2 I_D / \beta N_2)}) + I_D \cdot R \cdots (3) \quad \text{ただし、} N_1, N_2 \text{は、それぞれトランジスタTN1、TN2の反転層内の単位面積当たりの電子数である。}$$

ここで、(3)式を変形すると、次の式になる。

$$\sqrt{(2 I_D / \beta)} \cdot (\sqrt{(1 / N_1)} - \sqrt{(1 / N_2)}) + V_D - I_D \cdot R = 0 \cdots (4)$$

40

【0019】

(4)式より出力電流 I_D は、VD、R、 N_1 、 N_2 の関数となっている。そこで、出力電流 I_D は、VD、R、 N_1 、 N_2 の温度係数に依存することになる。このことは、VD、Rの温度係数が決定されて、その上で、 N_1 、 N_2 の値により、出力電流 I_D の温度特性をVD、Rの温度係数に応じて変化させることができることである。

そこで、トランジスタTN1、TN2のチャンネル幅（ゲート幅）比をパラメータとして N_1 、 N_2 の値を変化させたときの温度特性を調べてみると、基準電流発生回路1の出力電流に対して、図2のようなチャンネル幅（ゲート幅）比対温度特性を得ることができる。

なお、横軸は温度[°C]、縦軸は、トランジスタTN2の出力電流[A]である。ここで、 $N_1:N_2$ は、トランジスタTN1、TN2のチャンネル幅（ゲート幅）比に対応する。

50

図 2 において、グラフ A は、トランジスタ T N1, T N2 のチャネル幅比、すなわち、 $N1 : N2$ を、 $N1 : N2 = 1 : 5$ としたものであり、右下がりの特性が得られる。グラフ B は、 $N1 : N2 = 1 : 10$ としたものであり、 $-50^{\circ} \sim +50^{\circ}$ 付近までほぼ平坦でその後傾斜が小さい少し右下がりとなる特性が得られる。グラフ C は、 $N1 : N2 = 1 : 15$ としたものであり、 $-50^{\circ} \sim +100^{\circ}$ 付近まで少し右上がりではあるが実質的に平坦な特性が得られる。グラフ D は、 $N1 : N2 = 1 : 20$ としたものであり、右上がり特性が得られる。グラフ E は、 $N1 : N2 = 1 : 35$ としたものであり、さらに傾斜が大きい右上がり特性が得られる。

【0020】

これら特性グラフから、 $-10^{\circ} \sim +70^{\circ}$ 程度の装置が使用可能な温度範囲で、図 3 の発光材料の特性を打ち消す温度係数の特性を探ると、R では $N1 : N2 = 1 : 18$ 、G では $N1 : N2 = 1 : 13$ 、B では $N1 : N2 = 1 : 4$ が現在の R、G、B の発光材料に対して最適であることが分かった。

そこで、前記したように、図 1 においては、トランジスタ T N1, T N2 のチャネル幅比について、R の基準電流発生回路 1 R ではトランジスタ T N1, T N2 のチャネル幅比を $1 : 18$ とし、G の基準電流発生回路 1 G ではトランジスタ T N1, T N2 のチャネル幅比を $1 : 13$ とし、B の基準電流発生回路 1 G ではトランジスタ T N1, T N2 のチャネル幅比を $1 : 4$ に設定している。

これにより、温度に対する図 3 (a) ~ (c) に一点鎖線で示す各輝度特性 R c, G c, B c を得ることができる。

なお、前記の特性からみて、図 3 の温度特性から比率にして前後 2 程度の比の変化は、許容範囲として見込めるので、実際上は、R についてトランジスタ T N1, T N2 のチャネル幅の比の選択範囲は、 $1 : 16 \sim 1 : 20$ であり、G についてのチャネル幅の比の選択範囲は、 $1 : 11 \sim 1 : 15$ であり、B についてのチャネル幅の比の選択範囲は、 $1 : 2 \sim 1 : 6$ である。

【0021】

その結果、基準電流発生回路 1 の基準電流は、周囲の温度に応じて変化し、これに応じてホワイトバランス調整回路 2 (ホワイトバランス調整回路 2 R, 2 G, 2 B を代表して) の調整された基準電流も同様に变化する。各 D/A ブロック 6 は、MPU 9 からレジスタ 7 を介して表示データを受けてホワイトバランス調整回路 2 で生成された基準駆動電流を表示データ値分電流増幅してそのときどきの有機 EL 素子の表示輝度に応じた駆動電流をシンク電流として出力端子に発生する。これにより、カラム側の出力端子 (カラムピン) を介して駆動電流を有機 EL パネルのピクセル回路に出力する。

このときには、R についての温度に対する輝度特性は、図 3 (a) の点線の特性 R s で示すように補正されてほぼ平坦な特性を $-50^{\circ} \sim +70^{\circ}$ の範囲で得ることができる。B、G についても、図 3 (b), (c) の点線の特性 G s, B s で示すようにそれぞれほぼ平坦な特性を $-50^{\circ} \sim +70^{\circ}$ の範囲で得ることができる。

このように、輝度が温度変化に対して特性 R s, G s, B s とともに実質的に平坦になるように補正されるので、 $-10^{\circ} \sim +70^{\circ}$ 程度の範囲で表示装置使用の温度環境が変化してもホワイトバランスがほとんど崩れないで済む。

【0022】

ところで、実施例の基準電流発生回路 1 のカレントミラー回路 11 は、その入力側トランジスタに直列にダイオードを設け、出力側トランジスタに直列に抵抗を設けている。さらに、この発明は、これらダイオードや抵抗に換えて、他の温度係数が逆方向になる受動素子をそれぞれのトランジスタに直列に設けてもよい。

また、カレントミラー回路 11 のチャネル幅 (ゲート幅) 比は、(4) 式から明かなように、カレントミラー回路 11 の入力側トランジスタと出力側トランジスタとの動作電流比に対応するものである。

さらに、実施例の N チャネル MOS トランジスタは、P チャネル MOS トランジスタに、あるいはその逆に置き換えることができる。特に、D/A 4 の P チャネル MOS トラン

10

20

30

40

50

ジスタをNチャンネルMOSトランジスタに置き換えた場合には、電源側に配置されたD/A 4の各トランジスタがグランド側となり、そのソース側がグランドラインに接続される。D/A 6のNチャンネルMOSトランジスタをPチャンネルMOSトランジスタに置き換えた場合には、D/A 4とは前記とは逆にグランド側になる。

【産業上の利用可能性】

【0023】

以上説明してきたが、実施例では、D/A 6の出力を駆動電流として出力端子に出力する構成を採っているが、この発明は、出力端子に対応して出力段電流源をそれぞれ設けて、D/A 6の出力電流で出力段電流源を駆動して駆動電流を各出力端子に出力するようにしてもよい。

10

また、実施例の基準電流発生回路は、MOSトランジスタで構成しているが、この発明は、これをバイポーラトランジスタで構成してもよいことはもちろんである。基準電流発生回路がバイポーラトランジスタで構成される場合には、そのカレントミラー回路のチャネル幅（ゲート幅）比は、エミッタ面積比になる。

さらに、実施例では、シンク電流を出力するアクティブマトリックス型の有機ELパネルを駆動する実施例を挙げているが、この発明は、パッシブ型の有機ELパネルを駆動する場合であっても適用できることはもちろんである。パッシブ型の有機ELパネルを駆動する場合には、出力端子から出力される駆動電流は、通常、有機EL素子の陽極に出力される吐き出し電流となる。

実施例では、カラー表示の例を挙げているが、白黒表示の場合においても温度変化による輝度変化を補正することができるので、この発明の基準電流発生回路は白黒表示の有機EL駆動回路に対しても適用可能である。

20

【図面の簡単な説明】

【0024】

【図1】図1は、この発明の有機EL駆動回路を適用した一実施例の有機ELパネルのカラムドライバを中心とするブロック図である。

【図2】図2は、基準電流発生回路を構成するカレントミラー回路の入力側トランジスタ対出力側トランジスタのチャネル幅（ゲート幅）比をパラメータとした場合の駆動電流の温度特性の説明図である。

【図3】図3は、R、G、Bの発光材料の出力電流に対する一般的な温度特性の説明図である。

30

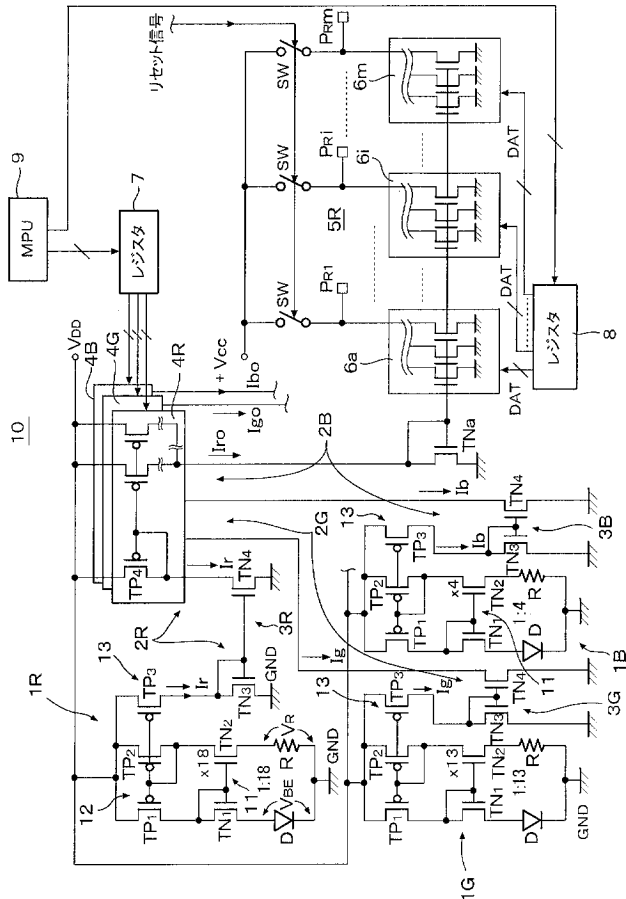
【符号の説明】

【0025】

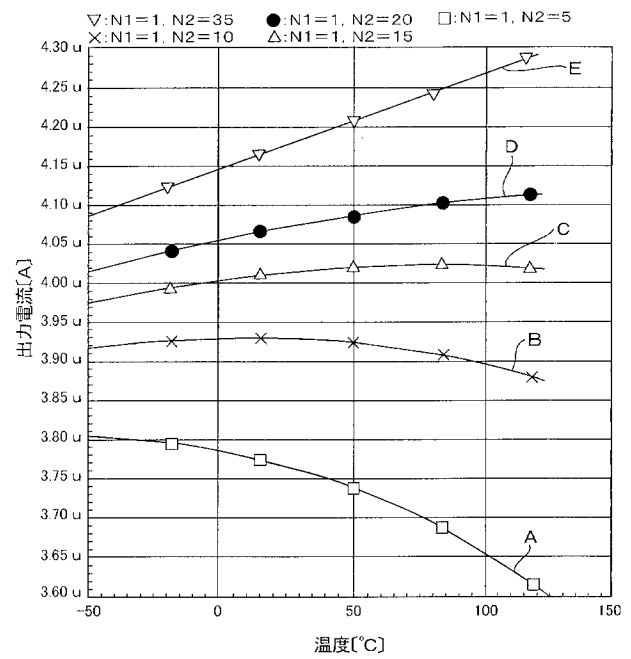
- 1 G、1 R、1 B… R、G、Bの各基準電流発生回路、
- 2 G、2 R、2 B… R、G、Bの各ホワイトバランス調整回路、
- 3 ……電流反転回路、4、6… D/A変換回路（D/A）、
- 5…基準電流分配型D/A変換回路、
- 6、6a、6i、6m… D/A変換ブロック、
- 7、8…レジスタ、9…MPU、
- 10…カラムICドライバ、
- 11…カレントミラー回路、12…負荷回路、
- 13…基準電流出力回路、
- TN1～TN5、TNa、TNb、TNm… NチャンネルMOSトランジスタ、
- TP1～TP4… NチャンネルMOSトランジスタ。

40

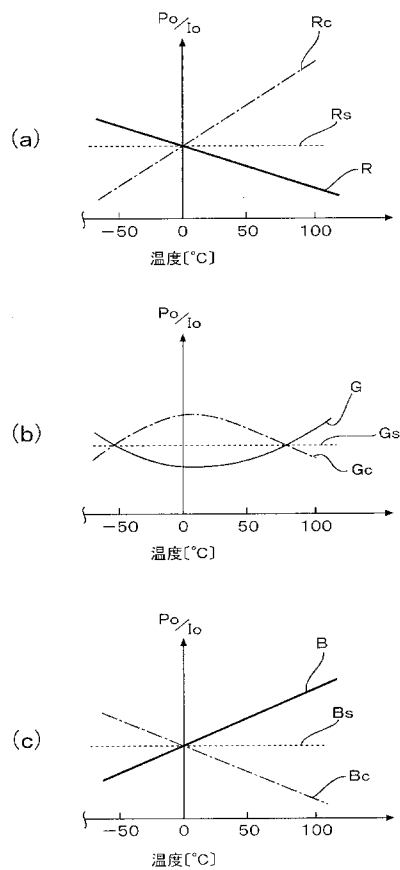
【図 1】



【図 2】



【図 3】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

F I

テーマコード (参考)

G 0 9 G	3/20	6 4 1 D
G 0 9 G	3/20	6 4 2 L
G 0 9 G	3/20	6 4 2 P
H 0 5 B	33/14	A

(72)発明者 阿部 真一

京都市右京区西院溝崎町 2 1 番地 ローム株式会社内

F ターム(参考) 3K007 AB05 AB17 BA06 DB03 GA04

5C080 AA06 BB05 CC03 DD05 EE28 EE30 FF11 JJ03 JJ05

专利名称(译)	有机EL驱动电路的参考电流产生电路，有机EL驱动电路和使用其的有机EL显示装置		
公开(公告)号	JP2005338794A	公开(公告)日	2005-12-08
申请号	JP2005117708	申请日	2005-04-15
[标]申请(专利权)人(译)	罗姆股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	ROHM株式会社		
[标]发明人	矢熊宏司 藤沢雅憲 阿部真一		
发明人	矢熊 宏司 藤沢 雅憲 阿部 真一		
IPC分类号	H01L51/50 G09G3/20 G09G3/30 H05B33/14		
FI分类号	G09G3/30.J G09G3/30.K G09G3/20.612.E G09G3/20.623.F G09G3/20.623.R G09G3/20.641.D G09G3/20.642.L G09G3/20.642.P H05B33/14.A G09G3/3216 G09G3/3225 G09G3/3275		
F-TERM分类号	3K007/AB05 3K007/AB17 3K007/BA06 3K007/DB03 3K007/GA04 5C080/AA06 5C080/BB05 5C080/CC03 5C080/DD05 5C080/EE28 5C080/EE30 5C080/FF11 5C080/JJ03 5C080/JJ05 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC02 3K107/CC08 3K107/EE03 3K107/FF17 3K107/HH03 3K107/HH04 3K107/HH05 5C380/AA01 5C380/AB05 5C380/AB06 5C380/AB31 5C380/AB34 5C380/AC11 5C380/AC12 5C380/BA11 5C380/BA12 5C380/BA42 5C380/BB12 5C380/BD01 5C380/CA01 5C380/CA34 5C380/CE04 5C380/CF06 5C380/CF26 5C380/CF41 5C380/CF46 5C380/CF48 5C380/CF62 5C380/CF66 5C380/DA07 5C380/DA50 5C380/HA02 5C380/HA09 5C380/HA13		
代理人(译)	梶山 信是 山本富士雄		
优先权	2004131013 2004-04-27 JP		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

[问题] 本发明的目的是提供一种有机EL驱动电路的基准电流生成电路，该基准电流生成电路能够在显示装置的广泛的工作温度环境下防止显示装置的发光亮度的变化。[解决方案] 本发明提供一种第一电流镜电路和输出侧晶体管，在该第一电流镜电路中，无源元件与输入侧晶体管和输出侧晶体管中的每一个串联设置，并且每个光接收元件的温度系数具有反向特性。第二电流镜电路被设置为第一电流镜电路的负载电路，用于将输出晶体管的输出电流反馈到输入侧晶体管的输入，以及根据在输出侧晶体管中产生的电流的电流。输出作为参考电流以产生驱动电流，并且将输入侧晶体管和输出侧晶体管的工作电流之比选择为用于校正相对于有机EL元件的温度变化的发光亮度的变化的值。有事 [选型图]图1

